

Transistor Mosfet Y60NK30Z

Codigo: **112876**



Descripción

Símbolo Parámetro Valor Unidad

- VDS Tensión de fuente de drenaje ($V_{GS} = 0$) 200 V
- VDGR Voltaje de compuerta de drenaje ($R_{GS} = 20$ k?) 200 V
- Voltaje de fuente de puerta $V_{GS} \pm 30$ V
- Corriente de drenaje I_D (continua) a $T_c = 25$ o C 60 A
- Corriente de drenaje I_D (continua) a $T_c = 100$ oC 40 A
- IDM (•) Corriente de drenaje (pulsada) 240 A
- Disipación total de P_{tot} a $T_c = 25$ o C 300 W
- Factor de reducción 2,4 W / o C
- Temperatura de almacenamiento T_{stg} -65 a 150 o C
- T_j Max. Temperatura de unión operativa 150 o C
- (•) Ancho de pulso limitado por área de operación segura 1/4